

## 「ワイドギャップ希薄磁性半導体」

- 日時 : 2005年10月13日(木) 13:00~18:05  
10月14日(金) 9:00~13:00
- 場所 : 東北大学金属材料研究所 講堂  
(仙台市青葉区片平2-1-1)

### プログラム

10月13日(木)

13:00~13:05 あいさつ

川崎雅司 東北大学金属材料研究所

【座長 : 川崎雅司 東北大学金属材料研究所】

13:05~13:30 ワイドギャップ希薄磁性半導体の基礎と問題点

吉田博 大阪大学産業科学研究所

13:30~13:55 III-V 族磁性半導体の諸物性とその応用(の可能性)

松倉文礼 東北大学電気通信研究所

13:55~14:20 遷移金属および希土類添加の GaN ベース希薄磁性半導体の成長と評価

朝日一 大阪大学産業科学研究所

14:20~14:45 希薄磁性半導体 GaCrN の物性

牧野久雄 高知工科大学総合研究所

14:45~15:10 強磁性半導体(Zn,Cr)Te のドーピングによる磁性変化

黒田眞司 筑波大学

15:10~15:30 休憩(20分)

【座長 : 田畑仁 大阪大学産業科学研究所】

15:30~16:10 ワイドギャップ希薄磁性半導体のスピノダル分解とその制御および磁性に与える影響

佐藤和則 大阪大学産業科学研究所

16:10~16:35 (Ga, Mn)As/ZnSe/(Ga, Mn)As-MTJ におけるトンネル磁気抵抗効果

齋藤秀和・湯浅新治・安藤功兒

独立行政法人 産業技術総合研究所

16:35~17:00 ルチル型  $Ti_{1-x}Co_xO_2$  の電子状態と光照射効果

溝川貴司 東京大学大学院新領域創成科学研究科

17:00 ~ 17:25 First Principles Investigation of Magnetic Circular Dichroism Spectroscopy of Co-doped Anatase and Rutile TiO<sub>2</sub>  
H. M. Weng · J. M. Dong · H. Mizuseki · Y. Kawazoe  
東北大学金属材料研究所

17:25 ~ 18:05 希薄磁性半導体の XMCD  
藤森淳 東京大学大学院新領域創成科学研究科

18:05 ~ 20:00 懇親会 (3号館6階セミナー室)

10月14日(金)

【座長：福村知昭 東北大学金属材料研究所】

9:00 ~ 9:40 希薄磁性半導体の輸送現象  
赤井久純・小倉昌子・米原仁  
大阪大学大学院理学研究科

9:40 ~ 10:05 二酸化チタンをベースにした磁性半導体のキャリア制御と磁性  
長谷川哲也 東京大学大学院理学系研究科

10:05 ~ 10:30 ZnO:Mn/ZnO ヘテロ界面の磁気・輸送特性  
藤村紀文 大阪府立大学大学院工学研究科

10:30 ~ 10:50 休憩(20分)

【座長：吉田博 大阪大学産業科学研究科】

10:50 ~ 11:30 半導体中の磁性不純物状態と磁気相互作用  
前川禎通 東北大学金属材料研究所

11:30 ~ 11:55 二酸化チタン光触媒の新機能 ”再” 開発 ~ 電子・磁性材料の可能性を探る  
松本祐司 東京工業大学大学院応用セラミックス研究所

11:55 ~ 12:20 ZnCoO/ZnO における磁気・光学特性  
田畑仁 大阪大学産業科学研究科

12:20 ~ 12:45 室温強磁性半導体 Co ドープルチル TiO<sub>2</sub> の強磁性とデバイス  
福村知昭 東北大学金属材料研究所

12:45 ~ 13:00 サマリー  
吉田博 大阪大学産業科学研究科

問い合わせ先：東北大学金属材料研究所

川崎雅司(kawasaki@imr.tohoku.ac.jp tel 022-215-2085)

福村知昭(fukumura@imr.tohoku.ac.jp tel 022-217-5600)